

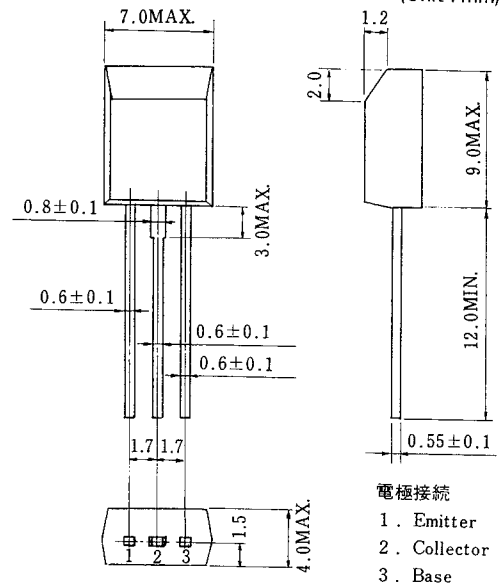
NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

○低電源電圧動作ラジオ、カセット等の低周波出力用に最適です。
○2SB564とコンプリメンタリで使用できます。

外形図/ PACKAGE DIMENSIONS

(Unit : mm)★



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	5.0	V
コレクタ電流(直流)	I _{C(DC)}	1.0	A
コレクタ電流(パルス)	I _{C(pulse)*}	1.5	A
全損失	P _T	1.0	W
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C

* PW ≤ 10ms, duty cycle ≤ 50%

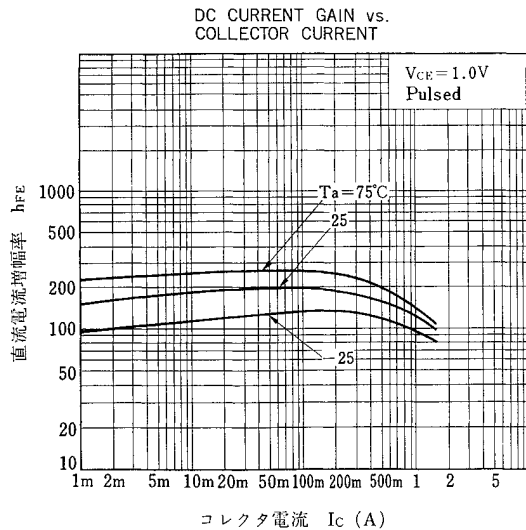
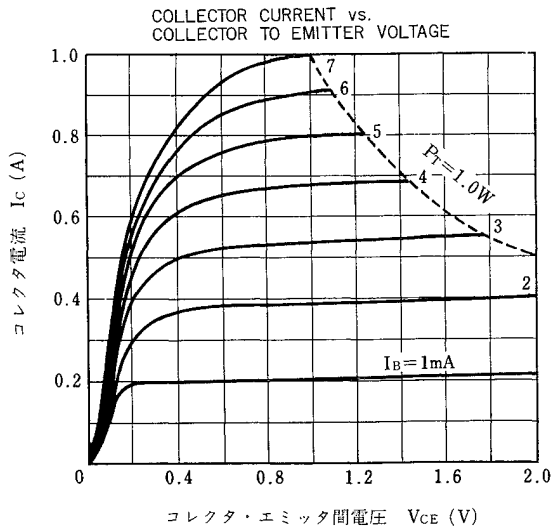
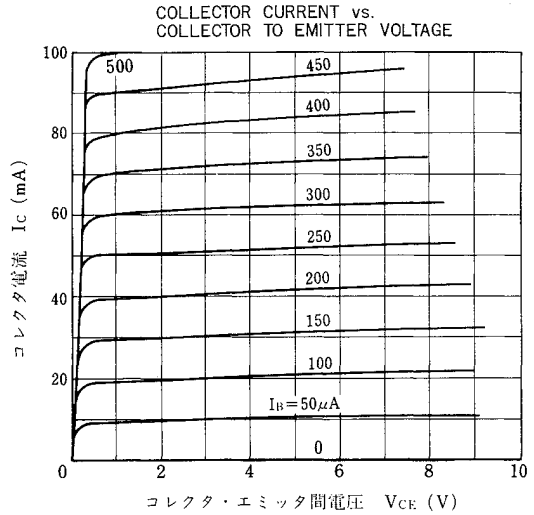
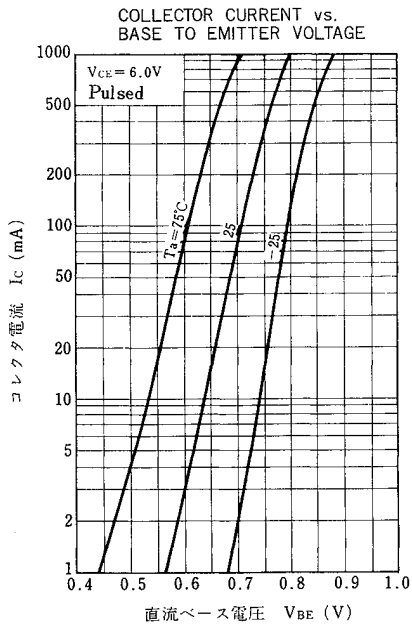
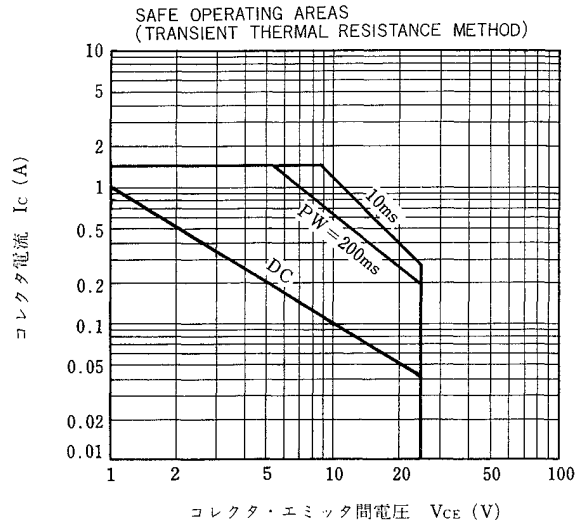
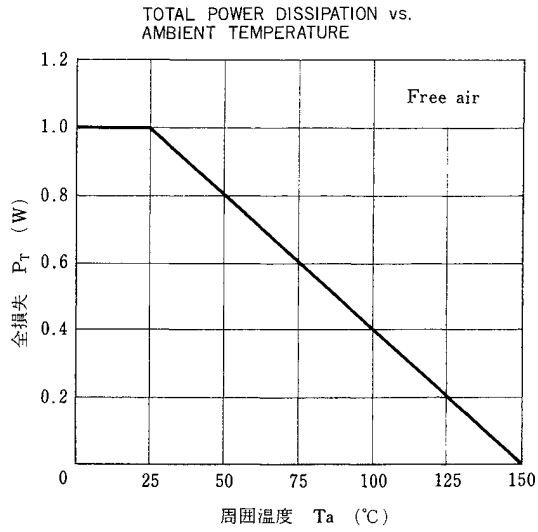
電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =30V, I _E =0			100	nA
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =5.0V, I _C =0			100	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =1.0V, I _C =0.1A *	90	200	400	
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} =1.0V, I _C =1.0A *	50	140		
直流ベース電圧	V _{BE}	V _{CE} =6.0V, I _C =10mA *	600	630	700	mV
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =1.0A, I _B =0.1A *		0.21	0.35	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =1.0A, I _B =0.1A *		1.0	1.2	V
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =6.0V, I _E =0, f=1.0MHz		22		pF
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =6.0V, I _E =-10mA		130		MHz

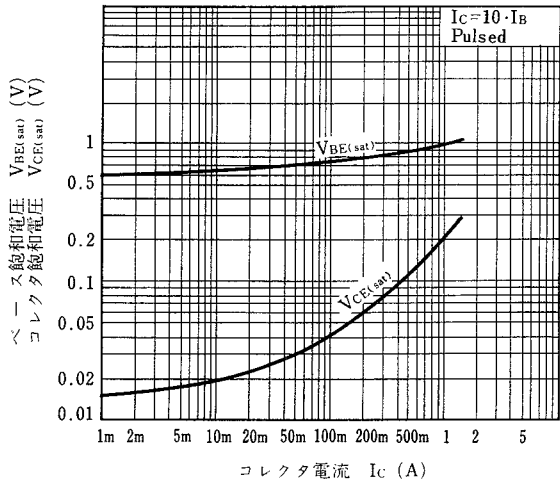
*パルス測定 PW ≤ 350μs, duty cycle ≤ 2% / Pulsed

h_{FE1}区分★/h_{FE1} Classification MA: 90~180 LA: 135~270 KA: 200~400

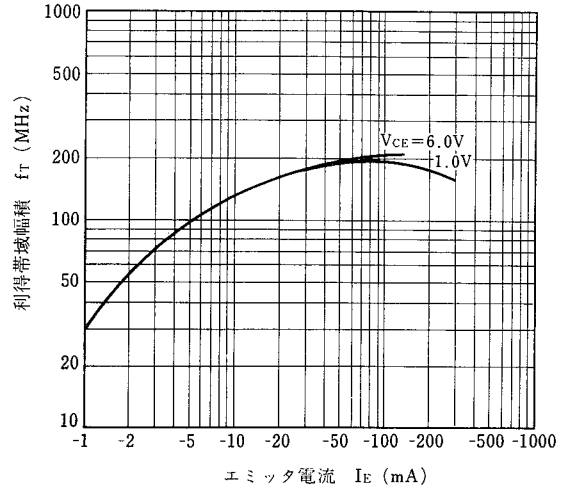
特性曲線 / TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)



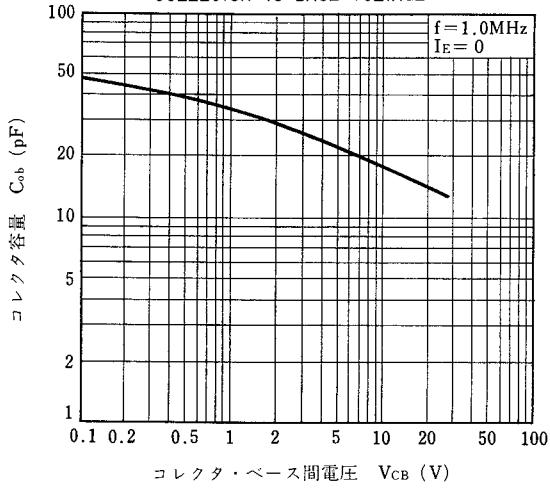
BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



NEC 日本電気株式会社

Table listing NEC branch offices across Japan, including addresses, phone numbers, and telex codes. Columns include office name, address, phone number, telex code, and branch name.